DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

#### 008286946

WPI Acc No: 1990-173947/\*199023\*

XRAM Acc No: C90-075658 XRPX Acc No: N90-135000

Photoreceptor for electrophotography - has rough hydrogenated amorphous silicon or carbon photoconductive layer coated with binder and lubricant layers

Patent Assignee: HITACHI CHEM CO LTD (HITB ); HITACHI LTD (HITA )

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

<u>Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week</u>
JP 2111962 A 19900424 JP 88264093 A 19881021 199023 B

Priority Applications (No Type Date): JP 88264093 A 19881021

## Abstract (Basic): JP 2111962 A

The photoreceptor has (A) a photoconductive layer on (B) conductive supporting base. The photoconductive layer is a rough-surfaced layer composed of hydrogenated amorphous silicon (or hydrogenated amorphous carbon). The photoconductive layer is coated with organic binder layer and surface-protective lubricant-layer having perfluoro-poly-oxyalkyl (or perfluoro-polyoxyalkylene) backbone.

Pref. overall film thickness of the organic binder layer and the surface-protective lubricant layer is 10-300 nm. Instead of forming an extra layer, surface-protective lubricant having non-fluorochemical segment and the fluorochemical segment may be incorporated in the organic binder layer.

USE/ADVANTAGE - By coating the amorphous-silicon-based photoconductive layer of the photoreceptor with the surface-protective layer contg. the fluorochemical lubricant, moisture resistance of the photoreceptor is improved without affecting its abrasion resistance. (6pp Dwg.No.0/0)ing

Title Terms: PHOTORECEIVER; ELECTROPHOTOGRAPHIC; ROUGH; HYDROGENATION; AMORPHOUS; SILICON; CARBON; PHOTOCONDUCTIVE; LAYER; COATING; BIND; LUBRICATE; LAYER

Derwent Class: A89; G08; P84; S06

International Patent Class (Additional): G03G-005/08

File Segment: CPI; EPI; EngPI

Manual Codes (CPI/A-N): A10-E08; A12-L05D; G06-A08; G06-F07; G06-H17

Manual Codes (EPI/S-X): S06-A01A2; S06-A01B

Plasdoc Codes (KS): 0210 0231 1279 3251 2654 2657 2658 2726 2729 2806 2808 Polymer Fragment Codes (PF):

\*001\* 014 04- 062 064 147 443 445 477 53& 532 533 535 575 596 597 598 599 609 658 659 725

Derwent Registry Numbers: 1520-U

	·		·		
					1
					•
					·
	ها مدين المهل الموليدية و با أن المستقدية والوطان الموليدية والمدينة والمراكبة الموليدية الموليدية والموليدية المدينة الموليدية الموليدية والموليدية والموليدية والموليدية والموليدية والموليدية والموليدية والموليدية المول	entegras (magratus engage) para di sa cara i di sa di sa A mandri mangrita di Alla di Sa d	سيدي معدد المريدة المداكن و المراكز المريدة المريدة المراكز المداكن الموضوعة المداكن الموضوعة المداكن المداكن المداكن المراكز المراكز المداكن المراكز	در به المحمد المحمد المحمد المحمد المحم المحمد المحمد المحم	tagen framer in secure personner of the control of
<b>3-4-</b>					
				•	
				•	
	•				
				•	•

## 19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2−111962

30 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)4月24日

G 03 G 5/08

309

7381-2H

審査請求 未請求 題求項の数 6 (全6頁)

## ②発明の名称 電子写真感光体

②特 顧 昭63-264093

②出 願 昭63(1988)10月21日

@発 明 者 小 沼 **鱼** 春 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研究所内

@発 明 者 石 川 文 紀 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研

究所内

⑩発 明 者 若 木 政 利 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研究所内

①出 顧 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 6 番地

⑪出 願 人 日立化成工業株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

砂代 理 人 弁理士 中 本 宏 外1名

最終頁に続く

明 細 電

1. 発明の名跡

冠子写真名光体

- 2. 将許納水の通過
  - 1. 超湿性落板上に忽光型を有する電子写真忽光体に知いて、前記忽光型が表面に凹凸を有する水準化アモルファスシリコン果材料又は水泉化アモルファスカーボン果材料の圏から成り、放然光型の表面には有機パインダー間とパーフルオロボリオキシァルキレングループを骨格とする最高に設置機能であることを特徴とする電子写真感光体。
  - 2. 専程性基板の表面に凹凸が形成されており、 放基板上の水果化アモルファスシリコン系材料 又は水果化アモルファスカーボン系材料の増か らなる名光性の表面は、前記浮湿性底板表面の 凹凸に沿つて凹凸が形成されており、飲寒光度 の表面には有機高分子フィルムによるパインダー 一溜が形成されており、前紀パインダー畑には

パーフルオロポリオキシアルキルグルーナ文は パーフルオロポリオキシアルキレングループと 非フツ楽含省グループを結合した樹造の個準例 が含有されて知り、総脳前側は非フツ杂合有グ ループがパインダー当中に固定され、パーフル オロポリオキシアルキルグループ又はパーフル オロポリオキシアルキレングループがパインダ - 一世安面に歴史的に析出して装面保護湖清遺を 形成しているととを特徴とする鬼子写真応光体。 前記忍光切は、水袋化アモルファスシリコン 果材料の増加 a - Si : H : B 。 a - SiC : H : B 。 a-SiC : H , a - SiGe : H , a - SiGe : H : B , a-SIN: Hより殴る群から遊ばれた一種又は二 **世以上の俎から成り、水名化アモルフアスカー** ポン系材料の目がa - C : H , a - C : H : 7 から選ばれた一組以上の目から成り、また、放 出光切の設面図がa - SiC : H . a - SiN : H. a - C : H , a - C : H : P 上り成る群から避 はれた一種又は二位以上の誰から成ることを特 敵とする柏水頂1又は2元战の双子写真腐光体。

わせて10~300ヵm であることを特徴とす 小さく、樹塚純性に劣るなどの欠点を有している。

ZARAIL ZAROPEROPERORERO ERRALRARIAMIZAMIZAMIZAMI

ポリオキシアルキルグループ又はパーフルオロ グループを結合した構造の調滑剤を含有した有 することを特徴とする請求項!又は2記載の還 ているが十分とは云えない。 子写真成光体の製造方法。

#### 五発明の詳細な説明

〔趙萊上の利用分野〕

印刷しても良好な邇像を形成させるのに好適な水 ため、例えば特顧昭61-22361号明細苷に 泉化アモルフアスシリコン系温光体に選する。 〔従来の技術〕

8 8 4 8 号公規に配成されているように熱可塑性 関脂質を設ける方法がある。しかし、上記方法で **社計温性と電子写真思光体の表面保護園として模** 求される他の特性即ち耐塞作性、クリーニング性 とが心らずしも並立しないという問題があり、特 化コツ岩米材料を表面保護制に用いる場合には、 謝恩性が大きく向上するものの樹稈氏性及びクリ ーエング性が苦しく劣化すると云う欠点があつた。 〔 差明が解決しようとする原題〕

上記述法技術では増子写成忍光体の表面保護が として要求される謝理性、附保活性及びクリーニ ング法の各々の特性を満足するには至らず、甲字 プロセスの繰り返し後に商溢化で画製流れが発生 し、 a-Si:H 忍光体の欠点を十分に克服できない という問題があつた。

水危明の目的は、電子写真窓光体にかいて、顧 湿性、消湿能性及びクリーニング性に遅れた炎河 保護関を設けるととにより、繰り返し使用しても 変質しない技術命の感光体を提供することにある。 ( 原選を解決するための手段)

6. 凹凸を有する忍光留表面上に、パーフルオロ 呆窓光体は硬度が高く、峭炬発性に優れているこ とから長寿命の電子写真恣光体として明待されて ポリオキシアルキレングループと非フツ裏含有 いる。しかしながらa-Si:H 悠光休には耐湿性に 劣るという欠点がある。とのため、 a-SiC :H々 假属分子パインダー潜を形成してのち、漁処理 どを表面保護者として設けることが一般的となつ

電子写真の印字プロセスにおいては、コロナ放 電による帯電プロセスが存在するため、 甲字プロ セスの娘り返しにより表面保護性が誰化し前温性 本籍羽は電子写真濫光体に保り、特に高湿下で が劣化する。とのような潮湿性の劣化を防止する 記載されているようにa-C:H:F頭、あるい 

> 本発明者らは、鋭度研究の結果、上記目的は、 核光智装而に凹凸を有するa-Si: H系及光体の 後表面に、 有收高分子パインダー ほと有機フッ共 | 不の表面保護機構習とを順次形成することにより 達成されるととを見い出し、本希明を完成した。

> - ナなわち、本発明は、導電性益板上に窓光道を 有する電子写真悠光体において、前記悠光層が衰 面に凹凸を有する水素化アモルファスシリコン系 材料又は水栽化アモルファスカーポン系材料のほ から成り、該窓光型の表面には有機高分子パイン ダー関とパーフルオロポリオキシアルキルグルー プ又はパーフルオロポリオキシアルキレングルー プを骨格とする表面保護網滑盤が形成されている ことを特徴とする電子写真窓光体に関し、また、 講聞性基板の表面に凹凸が形成されており、絃法 板上の水素化アモルファスシリコン系材料又は水 単化アモルファスカーポン系材料の質がらなる沼 光層の表面は、前記導電性基板表面の凹凸に沿つ て凹凸が形成されており、該窓光質の表面には有 被高分子フィルムによるパインダー質が形成され

ており、前記パインダー圏にはパーフルオロポリオキシアルキルグループ又はパーフルオロポリオキシアルキレングループと非フツ流含有グルーアを結合した構造の潤滑刷が含有されており、 該悶滑別は非フツ宏含有グループがパインダー 当中に協定され、パーフルオロポリオキシアルキレグループがパインダー 慰表面に選択的に析出して表面保益開州盟を形成していることを特徴とする選子写真必光体に測する。

前配過消削の非フツ公会有グループはパインダー海中に埋込固定されることにより、コロナ照射後の射世性に優れ、耐心発性、クリーニング性にも近れる基子写真恣光体を突現できる。

本卷明作用以名调附阁位下記一股武

$$R_1 - (R_1 - (R_3)_m - (R_3 - \sqrt{\bigcirc})_m - H)_m$$

(式中Rt はパーフルオロ化ポリオキシアルキル基、又はパーフルオロ化ポリオキシアルキレン 盐、

(式中、R<sub>I</sub> パーフルオロポリオキシアルキル グループ又はパーフルオロポリオキシアルキレン グループ)

本発明に用いる有國商分子パインダーは特に限 足されないが、硬化後少なくとも一部架幅してい ることが必要である。 a-S1:H 感光体の場合、硬 化塩度が存過ぎると感光型中の水気が脱感し、光 呼な性などの電子写真特性が低下するため、パイ Riは直摩結合または、 -CH<sub>1</sub>-、 -CO-, -CONH-, Riは良認数 2 ~ 3 のオキシアルキレン広、Ri は直接結合または -O-, -COO-, -CONH-, -NHCO-, -OCxH<sub>1</sub>x-, -C(CR<sub>2</sub>): -で繰り返しことに違つていても良い。 a は 1 又は 2 の遊飲、 m は 0 以上の強故、 n は 1 以上の強故、 x は 1 または 2 の遊散)で表わされる化合物である。

削記Rfが、パーフルオロ化ポリオキシアルキルグループの場合は下記一般式

F(C<sub>2</sub>P<sub>6</sub>-O-)<sub>L</sub>-(CF<sub>2</sub>O)<sub>y</sub>-(CF<sub>2</sub>)<sub>z</sub>-パーフルオロ化ポリオキシアルキレングループの 場合は下記一般式

- { (C<sub>1</sub>F<sub>4</sub>O-)<sub>V</sub>-(CF<sub>2</sub>O)<sub>Z</sub>-CF<sub>2</sub> }-

(式中 4 、 y 、 z は 1 以上の 整数、 望ましくは とは 5 以上、 y は 1 0 ~ 2 5、 z は 1 0 ~ 5 6 ) で示されるものである。 とれらのフツ 案化合物の 例はデユポン社から市坂されているクライトック ス 1 4 5 あるいはモンテフルオス社のホンブリン Y、 ホンブリン 2 などがある。

前記網構制の具体的な例としては

ンダーとしては300℃以下選至しくは250℃ 以下で硬化するものが好適である。

次にa-Si:H 感光体表面にパインダー質、 姿質 保護機構質を形成する方法の代表例を示す。バー フロロポリオキシアルキルグループ又はパーフロ ロポリオキシアルキレングループをもつ構造の間 揖刷と適当な公知の三次元硬化型バインダー 刷あ るいはR可密性のパインダー剤とを、これらが良 く俗符する有級俗例、例えばメナルエチルケトン と酢液ブチルセルソルブ、フロンソルベントの進 合したものに俗解する。その後、との浴液の痰を 退光型最重に形成する。形成の方法は浸渍法、回 転進布法など適宜避んで良い。その後、 BC∼120 ℃で 0.5~2 1 程度の燃処理を施し溶剤を蒸発さ せる。この政俗でパーフロロオキシァルキル並は パインダーとの風和性が小さいため、パインダー 脳表面に選択的に折出し、表面保護調解過を形成 する。非フツ楽含有グループはパインダー刈中に 埋込固定される。次いで180~3 11 0 ℃の温度 凝固内で1~3hの無処理を行うととにより、パ

インダー関の保備が促進されてパインダーだ中へ の非フッ 女グループの固定がより強固なものにな ると共に、 表面保護調備関の形成も完成する。

パインダー図と表面保護機構製の厚さは、浮過ぎると冠子写真特性の内題留記位を増大させるなど好文しくなく、適常は両者合せて1.0 nm~300 nm が用いられ、特に100 nm 以下が観文しい。

「原厚100 nm 以下では上述の有機成分子閣を形成しても、光辺冠性、帯電特性などに何ら影響を及ぼすことはない。

また、表面保護協滑層は、密光層の設出部に対 する弦装面保護関構製の選出部の影面類比が1以 上とするのがよい。

本 発明において、 忽光質としては、 公知の水素 化 アモルファスシリコン果の思光体が使用できる が、 具体的には水素化アモルファスシリコン系材料の質は、 a-Si:H:B, a-SiC:H:B, a - SiC:H, a-SiGe:H, a-SiGe:H:B, a-SiN:H:D 成る罪から選ばれた一種又は二種以上の資から成り、 水器化アモルファスカーボ

## 

以下、本語明の一例を剪1図により説明するが 水角明はこれらの摂施例に限定されるものではな い。

#### 买施例1

選 1 図は本発明による a - S1 : H 窓光体の機構 値を模式的に示した機断面図である。外径 f 262 × 浸さ 4 5 0 mm の A2 ドラム 25 体 1 0 変面に 1 μm 以下 a 1 μm 以上の凹凸を形成した。凹凸の 保さ は 皮面 保 質 凹 1 3 の 全 概 遅 に 依 存 し、 最 適 に は そ の凹凸は a 5 μm が良い。 せた、 基 f 央面を凹凸 ン果材料の別は、 a - C : H , a - C : H : Fの
一盤又は二値から成り、また、該窓光質の各値が
は、 a - SiC : H , a - SiN : H , a - C : H ,
a - C : H : F I り成る群から迎ばれた一種又は
二類以上の型からなるものが用いられる。

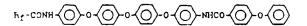
そして、30個性基板の表面に凹凸を形成することにより、忽光相にも同様な凹凸を形成し、基板表面と忽光泪の付着性をよくすることができる。 (作用)

化することによつて必光切101の付着性が労大 し、戦制艦を防止する。

この基体上に代設例としてa-SiC:H:Bのブロッキング間11を2 μm、a-SiC:H:Bの遺伤 治生 報送 切12を30 μm、a-SiC:Hの表面保護 図13をQ5μm 成映した。ことで、ブロッキング圏にはこの他にa-SiC:H,a-SiN:H、電荷 治生 超送 智には受破 投稿 脳関化をはかるため a-SiOe:H、 殺面保護 智には a-SiN:H。 a-C:H。 a-C:H:Fの一種又は2 値以上の復 づにして も良い。a-Si:H 悠光溜101の成長はブラズマCVD接 間により、 高別 は 101の成長は アス でて VD接 間により、 高別 は 切 500 以、 放電 正力 67 Pa、基体 個度 250 ℃、 反応 ガス 総 流生 400 sccm の作 製条件である。

次にとの窓光体をプラズマ C V D 接世より取り出し、本発明になる有機表面保護日 2 0 1 を値布した。原布度として、メチルエチルケトン 1 3 0 0 g、酢酸エチレングリコールモノーローブチルエーテル 1 3 0 9、フロンソルベント 6 5 9 を温せ合わせた俗間に、エポキン姆脂 4 4 9、フェノー

ル 31 筋 5 0 8、トリエチルアンモニウムカリボール 塩 0 0 4 9 を混合し、化学制造式が



(式中 R<sub>f</sub> はF(CF(CF<sub>3</sub>)-CF<sub>2</sub>O-)<sub>n</sub>-CF(CF<sub>3</sub>)-でn=平均14)
で示される恐情剤23を049をさらに混合した
ものを作製した。との母液に上述の a - S1 - H 感
光体を受演して、表面に有機パインダー型を成談した後100℃1hの予備加熱、200℃2hの 加熱硬化を施して有限姿面保護型201を完成した。成蹊後の加熱により、有機パインダー層21
の表面に関済剤のパーフロロボリオキシアルキル 造が空向析出し、姿面保護測滑型22が形成され 打壊パインダー母21中に潤滑剤の非フツ 名含有 グループが埋込却定される。

このようにして得た悠光体をレーザビームブリンタに実験し恒温恒恒室内にて印字試験を行つた。 恒温恒温室内の温度を20℃から25℃の範囲に、 また、相対湿度を破布80分まで変化させた。こ の時、悪象洗れは頻復されず良好な田字性能が得

#### (発明の効果)

本語明によれば、本記録の有限パインダー対及 び設面保護期間留を、忽光因表面に凹凸を有する a-S1:日君光体上に損欠形成することにより、 疑期限り返し使用において、耐湿性、クリーニン 少性、耐湿既性に優れ、かつ感光短の刺離が防止 された良寿命の電子写真露光体が実現できる。

### 4. 凶面の簡単な説明

10 ··· A L 蓝体 11 ··· プロツキング質

101 ··· a - Si : H 总光 划

2 1 … 有機パインダーゼ

22…有微数值保護调消增

2 3 … 汹游剑

201 … 有限设面保護证

られた。

#### 突焰例 2

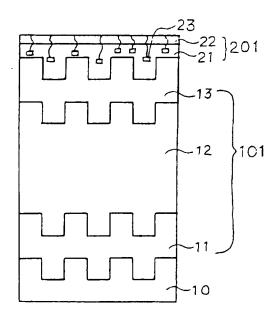
契施例1と同様にして a - S1: H 形光体を作製し、次いで 契施例1の独布液のうち、 樹梢別を第1 要に示す 7 種類に変えて有機表面保証目を形成した。 得られた忽光体を契施例1と同様条件にて 中学試験を行ったがいずれも 頭像 流れは発生せず 良好を甲字性能を示すことを認めた。

第 1 获

Ħ	母 前 例 磁
-	R <sub>1</sub> -CH, -0-0-0
2	R(-CH;-(0-0-);-0-0
5	н <sub>1</sub> -соос, н, -(Э)
4	Rf-co(oc: H, )4-och: -(0)
5	0-0-0-HHCO-R1-CONH-0-0-0
6	и - соин - (0) - 0 - (0) - инсо - (0)
,	R1-CONH-(0)-0-(0)-C(CH1)1-(0)-0-(0)-HHCO-(0)-0-(0)

(式中RfはF(CF(CF:)-CF:0-)n-CF(CF:)-でロ=平均14]

第 1 図



# 特閒平2-111962(6)

	第1頁	〔の約	きき					
	個発	明	者	玉	楯	邦	裕	茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 究所内
	⑰発	明	者	華	团	雅	侰	茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 究所内
-	⑦発	明	者	庄	司	Ξ	良	茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研
2	@発	明	者	ф	川路	孝	行	完所内 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 究所内
	⑦発	明	者	伊	膵		豐	茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 究所内
	個発	明	者	小	松崎	茂	樹	茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 究所内
	@発	明	者	山	岸	智	明	茨城県日立市東町4丁目13番地1号 日立化成工業株式会 社山崎工場内